

2N6714 2N6715 NPN
2N6726 2N6727 PNP

**COMPLEMENTARY SILICON
POWER TRANSISTORS**



TO-237 CASE



www.centrasemi.com

DESCRIPTION:

The CENTRAL SEMICONDUCTOR 2N6714, 2N6726 series types are complementary silicon plastic power transistors designed for general purpose power amplifier and switching applications.

MARKING: FULL PART NUMBER

MAXIMUM RATINGS: ($T_A=25^\circ\text{C}$)

Collector-Base Voltage
Collector-Emitter Voltage
Emitter-Base Voltage
Continuous Collector Current
Continuous Base Current
Power Dissipation
Power Dissipation ($T_C=25^\circ\text{C}$)
Operating and Storage Junction Temperature
Thermal Resistance
Thermal Resistance

SYMBOL	2N6714	2N6715	UNITS
	2N6726	2N6727	
V_{CBO}	40	50	V
V_{CEO}	30	40	V
V_{EBO}		5.0	V
I_C		2.0	A
I_B		0.5	A
P_D		1.0	W
P_D		2.0	W
T_J, T_{stg}	-65 to +150		$^\circ\text{C}$
Θ_{JA}		125	$^\circ\text{C/W}$
Θ_{JC}		62.5	$^\circ\text{C/W}$

ELECTRICAL CHARACTERISTICS: ($T_A=25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)

SYMBOL	TEST CONDITIONS	MIN	MAX	UNITS
I_{CBO}	$V_{CB}=\text{Rated } V_{CBO}$		0.1	μA
I_{EBO}	$V_{EB}=5.0\text{V}$		0.1	μA
BV_{CBO}	$I_C=1.0\text{mA}$, (2N6714, 2N6726)	40		V
BV_{CBO}	$I_C=1.0\text{mA}$, (2N6715, 2N6727)	50		V
BV_{CEO}	$I_C=10\text{mA}$, (2N6714, 2N6726)	30		V
BV_{CEO}	$I_C=10\text{mA}$, (2N6715, 2N6727)	40		V
BV_{EBO}	$I_E=1.0\text{mA}$	5.0		V
$V_{CE(SAT)}$	$I_C=1.0\text{A}$, $I_B=0.1\text{A}$		0.5	V
$V_{BE(ON)}$	$V_{CE}=1.0\text{V}$, $I_C=1.0\text{A}$		1.2	V
h_{FE}	$V_{CE}=1.0\text{V}$, $I_C=0.1\text{A}$	60		
h_{FE}	$V_{CE}=1.0\text{V}$, $I_C=1.0\text{A}$	50	250	
f_T	$V_{CE}=10\text{V}$, $I_C=50\text{mA}$, $f=20\text{MHz}$	50	500	MHz
C_{ob}	$V_{CB}=10\text{V}$, $I_E=0$, $f=1.0\text{MHz}$		30	pF

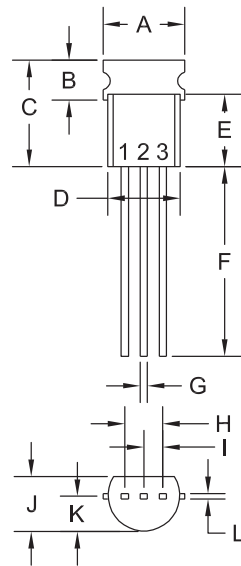
R1 (31-July 2012)

2N6714 2N6715 NPN
2N6726 2N6727 PNP

**COMPLEMENTARY SILICON
POWER TRANSISTORS**



TO-237 CASE - MECHANICAL OUTLINE



R1

DIMENSIONS				
SYMBOL	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	0.160	0.215	4.06	5.46
B	0.095	0.105	2.41	2.67
C	0.260	0.280	6.60	7.11
D (DIA)	0.175	0.205	4.45	5.21
E	0.170	0.210	4.32	5.33
F	0.500	-	12.70	-
G	0.016	0.022	0.41	0.56
H	0.100		2.54	
I	0.050		1.27	
J	0.125	0.165	3.18	4.19
K	0.080	0.105	2.03	2.67
L	0.014	0.016	0.36	0.41

TO-237 (REV: R1)

LEAD CODE:

- 1) Emitter
- 2) Base
- 3) Collector

MARKING: FULL PART NUMBER

R1 (31-July 2012)

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9